Requested Patent

JP56142629A

Title:

VACUUM DEVICE:

Abstracted Patent

JP56142629:

Publication Date:

1981-11-07;

Inventor(s):

TSUMURA SUEO ;

Applicant(s):

NEC CORP:

Application Number:

JP19800046690 19800409 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/205; H01L21/265; H01L21/285; H01L21/302; H01L21/31;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To enable continuous treatment in high vacuum by forming a slit, through which semiconductor wafers can pass, to a block connecting several vacuum chambers, the degree of vacuum thereof is increased by stages.

CONSTITUTION:A slit 3A in an extent that semiconductor wafers 1 can pass is made up to a block 3 conneting several vacuum chambers, which have exhaust pipes and the degree of vacuum thereof is increased by stages, and the semiconductor wafers 1 are successively transported to the next vacuum chambers by means of O ring belts 2 (4 are O ring belt holes). Thus, the wafers 1 can continuously be sent into high vacuum chambers from atmospheric pressure without using vacuum valves.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—142629

①Int. Cl. ² H 01 L 21/205 21/265 21/285	識別記号	庁内整理番号 7739—5F 6851—5F 7638—5F	②公開 昭和56年(1981)11月7日発明の数 1審査請求 未請求
21/302 21/31		6741—5F 7739—5F	(全 3 頁)
2401		7,00	

の真空装置

②特 顧 昭55-46690

②出 顧 昭55(1980)4月9日

の発明 者 津村末朗

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

切出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

10代 理 人 弁理士 菅野中

明 編 1

1.発明の名称

真空装置

2.特許請求の範囲

(1) 段階的に其空度を高めた幾つかの実空室と、その各其空室を脱気する排気管と、各其空室を連結するプロフタとからなり、プロフタに半導体ウェハースが通過出来る程度のスリットを設け、半導体ウェハースをスリットを過して一の真空室から他の真空室へ移送する 0 リングベルトをプロックと真空室とに表つて配散してなる真空装置。

3.発明の詳細な説明

半導体ウェハースの生産プロセスにおいて、 近年、真空中で処理を行う工程が多くなつている。たとえば、蒸着、スペッタリング、プラズマスタリング、プラズマスタリング、プラズマスタリング、プラズマスを見ることとろが、大気中のウェハースを処理金である真空宝内に入れるに当つて、ほとんどのもの はパッチ処理によつて行をわれ、又、キャリアックキャリアでないためにウエハースハンドリングが非常に頻嫌であつた。

本発明は、複雑な機構を用いずにキャリアからウェハースを一枚ずつ高真空室に送り込み再び大気中のキャリアに連続的に戻すことの出来 る真空装置を提供するものである。

以下本発明の実施例を図によつて観明する。 第1図において、1はウェハース、2はウェハースを乗せて搬送するための0リングペルトで ある。酸ペルト2は、直方体プロック3にあけ られた孔4を通して酸プロック3になって にまたがつて配散され、プロック3にはウェハース1が通ることができる程度の大きさのスリット3Aが開口されている。

第2図はローダ個又はアンローダ側のキャリア 6 からウエハーが出て行き又逆にキャリア 6 に入つてくる部分を示す。図中7は真空室の一つを示し、8 はその排気音である。 5 はキャリアに1 ピッチずつ上下送りを与えるエレベータ

である。

第3 図は本発明の金体のシステムの一実施例を示すものである。キャリア 6 から出たウェハースは 71 ~ 74 ~ 71 までの各実空室を通りキャリア 6 に入る。

各真空室はそれぞれ拼気管 8 に設けたパルブ 9 を介して下記の真空変に排気されている。

里 71 は 10 Torr

室 7# は 10-1 Torr

室 78 は 10 - 1 Torr

室 74 は 10-5Torr. (ウェハー処理室) 各室はそれぞれの実空変化応じた種類のポンプで脱気されている。

本発明において、各実空室の間にはいつさい パルプがなく其空室の両端には、第1回に示す スリットを持つたブロック3で連結されている。 したがつて、各室の真空度は所要の値に保持 されているかどうかが問題となる。

プロック3のコンダクタンスロを計算すると 次のとおりである。

ととで、相撲する真空室の真空度を Pn「Torr」 Pn+1「Torr」とするとn 番目の室からn+1番目 の室に使入する(今 Pn>Pn+1 とする) ガス量は

Qin = Pn·C である。

Pa+1 室に付いているポンプの実効排気スピードを a+18eとすれば

n+1⁸e · Pn+1 = Q1n = Pn · Cでペランスする。

$$n+18_6 = \frac{P_n}{P_{n+1}} \cdot C = 100 \cdot C$$
 (4)
(1)、(2)、(3)式の結果からでは較大でも0.6
「4/8」であるから

n+1⁸e = 100 × 0.6 = 60 [L/8]
となり、各室には 60 [L/8] 以上の排気スピードのポンプをつないでかけば、第 3 図のシステムにより充分に各軍の真空度が保たれることが 判る。

すなわち、本発明の実施例では第 1 図に示す ブロック 3 のスリットの高さ a = 1 「 mm 」 スリットの巾 b = 100 「mm」 ブロックの長さ

. の時 粘性流で KR ≒ 0.02

分子流で KR = 2 であるから $V_{\mu}^{0} = 0.26 \cdot 0.02 \cdot \frac{0.1^{2} \times 10^{2}}{10} \frac{1000 + 10}{2}$ $= 0.26 \lceil L/8 \rfloor (760 \text{Torr}(AIM) \sim 10 \text{Torr})$ 同様化

 $= 0.0026 [L/8] (10 \text{Torr} \sim 10^{-1} \text{Torr}) (1)$ $= 0.000026 [L/8] (10^{-1} \text{Torr} \sim 10^{-3} \text{Torr}) (2)$ $= 0.6 [L/8] (10^{-4} \sim 10^{-6} \text{Torr}) (3)$

と= 100 「mm」とし、各真空室にはそれぞれの真空度に応じた種類の実効排気スピード 60 「ℓ/8」以上の排気系及びポンプを設ける事により図3 に示す様なシステムで両端開放でウェヘースを大気圧から 10⁻⁸ 「Torr」に被圧し、又逆に大気圧まで連続的に通過させるととが可能となった。

以上のように本発明によれば、何ら真空ベルブを用いる事なくウエハースを大気圧から高真空室内に連続的に送り込み、又逆に高真空室内より連続的に大気中にウエハースを取出す事ができ、全行程を0リングベルトに乗せてキャリアンウキャリアで処理を行なうことができる。

なぶ、第3図のシステムは一実施例であり、 $P_{n+1}=10^{-2}\cdot P_n$ とすれば、

処理室の真空度 10^{-5} [Torr] にとどまらず、 さらに、高真空(実際はポンプモの他の関係で 10^{-7} [Torr] 根底)に上げることも可能である。

4.図面の簡単な説明

第1回は各真空窟連結プロックの斜視図、第 2回はロード、アンロード端部を示す側面図、

兹 3 図は全システム系統図である。

- 1 …ウエハース
- 2 …0リングベルト
- 3 ープロック
- 34 …スリット
 - 4 …0リングペルト穴
 - 5 …キャリアエレベータ
 - 6 …キャリア
 - 7 … 71 ~ 74 真空室
 - 8 …美気管
 - 9 ... パルブ

符許出顧人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 替 野 中



